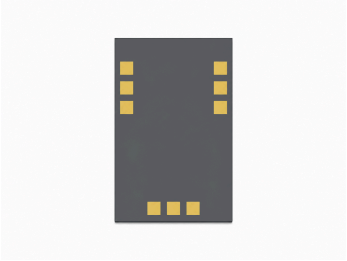
2000–6000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.



Características RF · TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	-	2000	-	6000	2000–6000	MHz
Aislamiento	-	-	20	-	-	dB
VSWR de entrada	-	-	1.3	-	-	-
VSWR de salida	-	-	1.2	-	-	-

Valores límite

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Potencia de entrada máxima	-	-	-	30	dBm

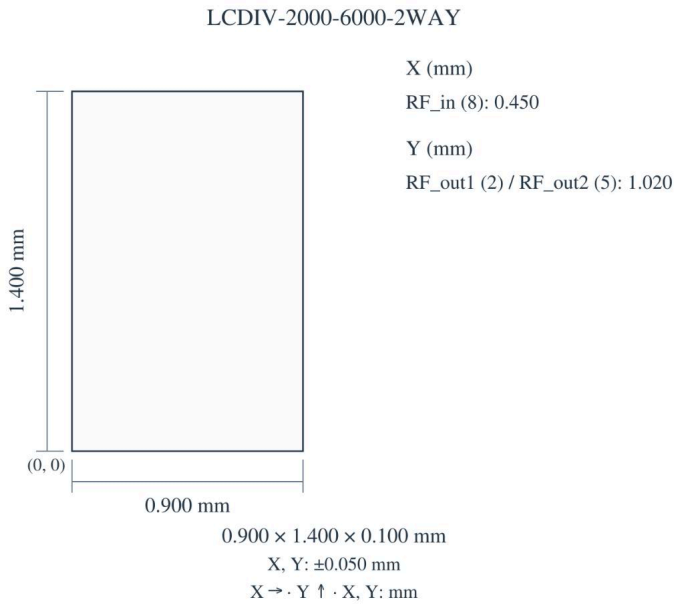
Condiciones ambientales

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de funcionamiento	-	-55	-	85	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	0.9 × 1.4 × 0.1	mm

Plano dimensional mecánico



Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	Función	Notas
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	Masa; no requiere hilo de unión	-
2	RFout1	Salida RF	1
5	RFout2	Salida RF	2
8	RFin	Entrada RF	-

Registro de la publicación actual · 1.3 · 2026-10-27. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.2.

Alcance de la referencia mecánica

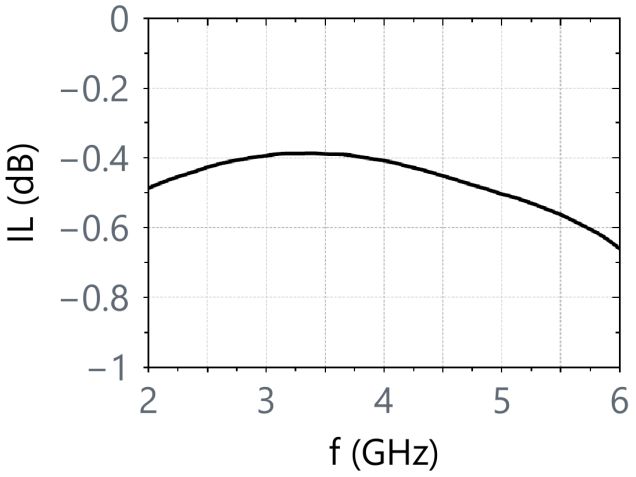
Guía dimensional en mm basada en la documentación de origen. Información parcial; no constituye un plano completo de fabricación o de unión por hilos.

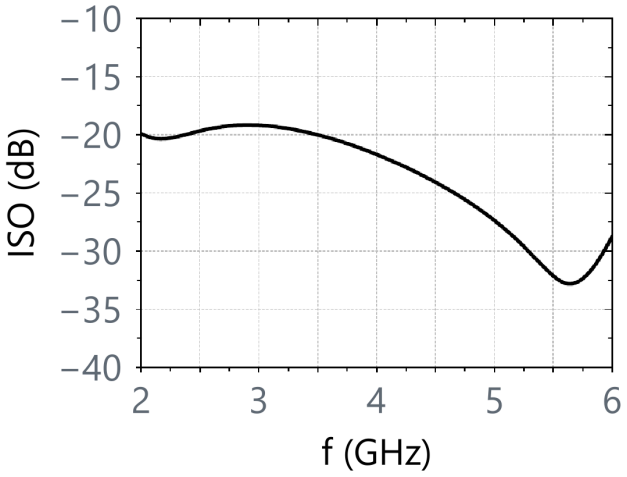
Curvas de rendimiento

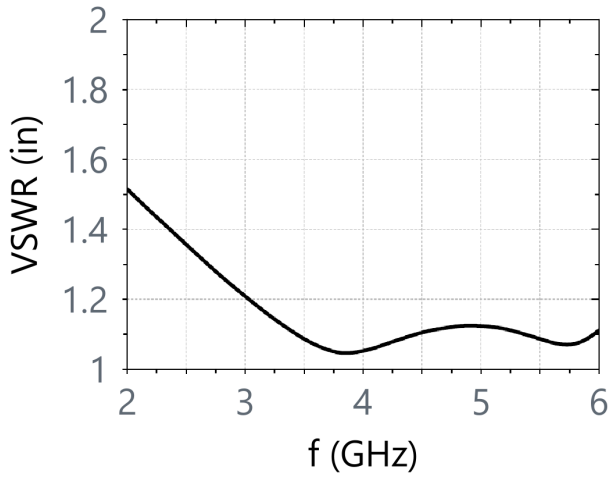
Gráficas de la hoja de datos original. Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

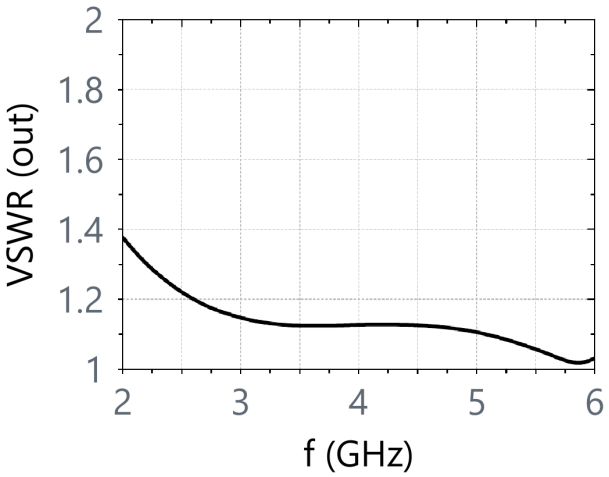
Pérdida de inserción; Aislamiento; Adaptación de entrada; Adaptación de salida.

Se conservan las áreas gráficas originales mostradas, incluidas curvas y cuadrícula; solo se reformatean los ejes exteriores y la disposición. No se reconstruyen series de mediciones ni estados ocultos.









Fuente

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.